

锁存型霍尔开关传感器

XL534

特点

- 宽工作电压范围：3.3V~90V
- 输出端抗浪涌电压： $\geq 90V$
- 支持输入电源防反接功能
- 器件HBM ESD分类等级Class3B
- 温度等级0级：-40℃至150℃的环境工作温度范围
- 低静态电流：2.2mA
- 30mA负载能力
- 磁场对称性好
- 磁场工作点：+55Gs
- 磁场释放点：-55Gs
- SOT23-3封装

描述

XL534专为电机类应用优化设计的高电压、宽温度范围的锁存型霍尔开关传感器，支持3.3V到90V的宽电源供电，具有较低的工作电流。采用集电极开路输出架构，提供高达30mA的负载能力，广泛应用于汽车电子、工业控制等领域。

XL534内部集成了基准电压源、霍尔阵列、差分比较器、迟滞锁存器和功率输出级等电路模块，在全电压范围和全温度范围内具有较高的磁场响应灵敏度、对称性和较强的抗电磁干扰能力。

应用

- 直流无刷电机
- 电机和风扇控制
- 位置和速度传感

典型应用示意图

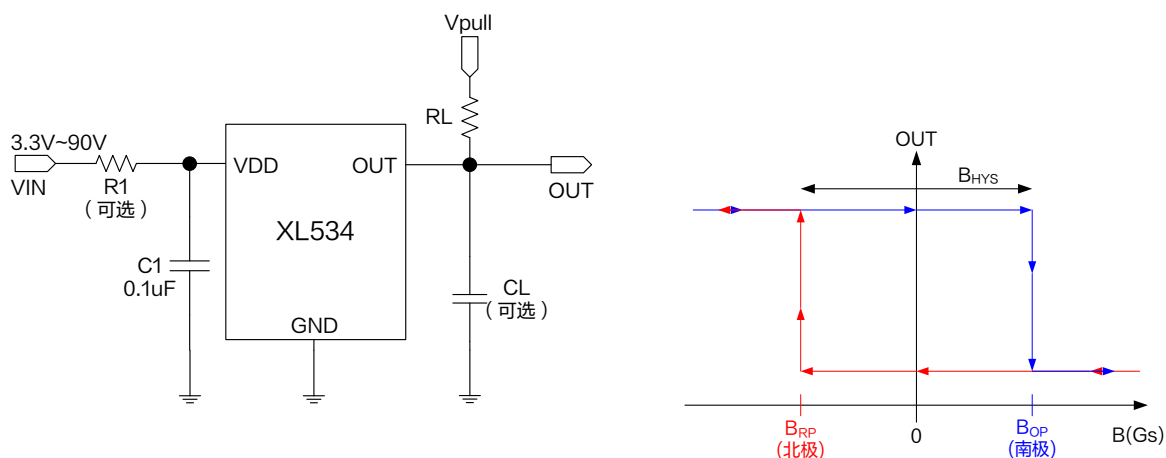


图 1.XL534 典型应用示意图和输出特性曲线

锁存型霍尔开关传感器

XL534

引脚配置

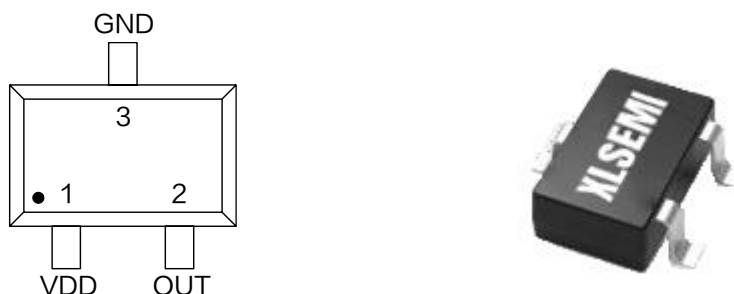


图 2.XL534 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	VDD	电源输入引脚，支持 DC3.3V~90V 宽电压操作范围。
2	OUT	集电极开路输出，使用时需要外接上拉电阻。
3	GND	接地引脚。

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	环保认证	包装类型
XL534	XL534	SOT23-3	RoHS & HF	3000 只每卷

方框图

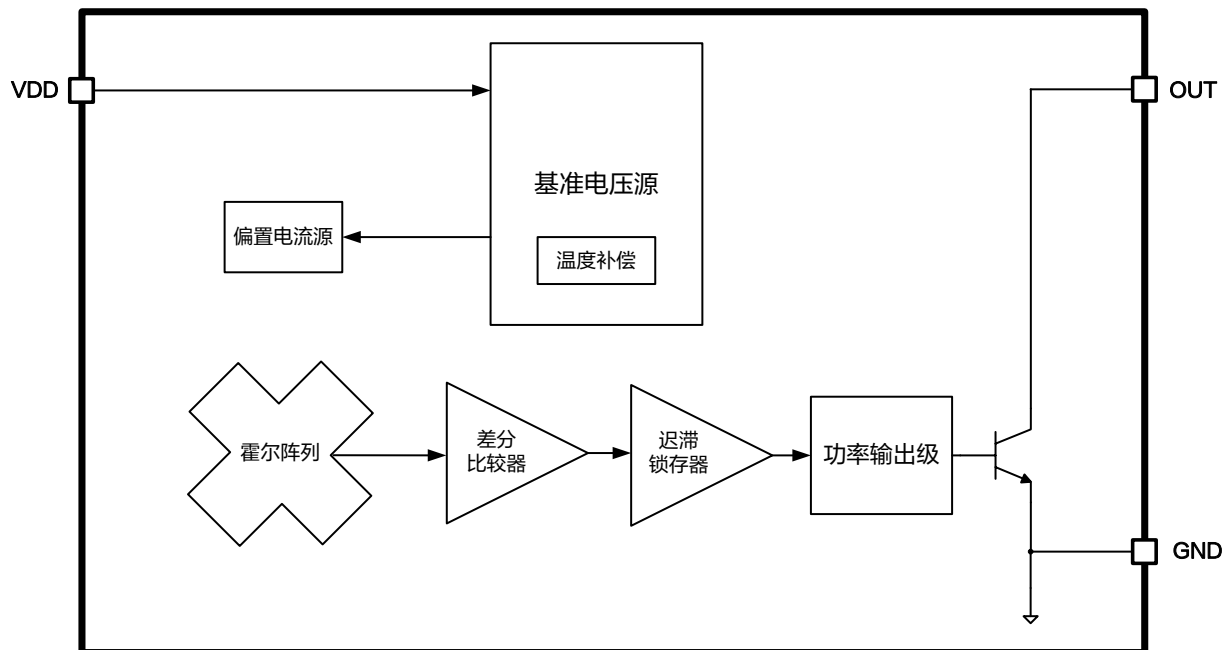


图 3.XL534 功能方框图

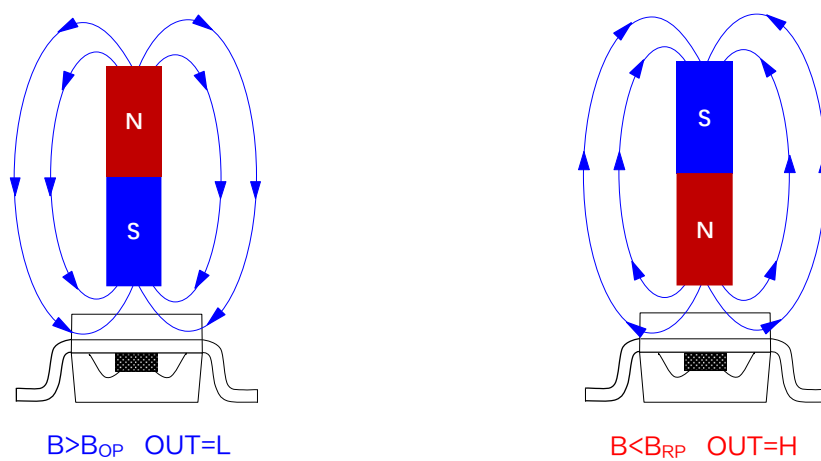


图 4.XL534 磁场方向定义图

锁存型霍尔开关传感器

XL534

绝对最大额定值（注1）

参数	符号	值	单位
输入引脚电压	V_{DD}	-90 ~ 120	V
输出引脚电压	V_{OUT}	-0.5 ~ 90	V
输出灌电流	I_{SINK}	0 ~ 30	mA
热阻（SOT23-3） （结到环境，无外部散热片）	R_{JA}	200	°C/W
工作温度	T_A	-40 ~ 150	°C
最大结温	T_J	-40 ~ 175	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65 ~ 175	°C
引脚温度（焊接10秒）	T_{LEAD}	260	°C
ESD（人体模型）	—	≥8000	V

注1：超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

锁存型霍尔开关传感器

XL534

XL534 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = V_{Pull} = 5\text{V}$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, $R_1 = 0\Omega$, 图1系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	—	3.3	5.0	90	V
输入端抗浪涌电压	V_{DD_Surge}	$D=25\%$, $T=20\mu\text{s}$, 10 个周期, $B > B_{OP}$	130	—	—	V
输出端抗浪涌电压	V_{OUT_Surge}	$D=25\%$, $T=20\mu\text{s}$, 10 个周期, $B > B_{OP}$	90	—	—	V
电源反向电压	V_{DDR}	—	-90	—	—	V
静态电流	I_Q	OUT=H	—	2.2	—	mA
工作电流	I_{DD}	OUT=L	—	3.2	—	mA
上电时间	t_{ON}	—	—	35	50	μs
饱和压降	V_{CE}	$I_{OUT}=20\text{mA}$	—	—	0.5	V
输出延时时间	t_d	$B=B_{RP}$ to B_{OP}	—	10	25	μs
输出上升时间	t_r	$CL=50\text{pF}$	—	—	0.5	μs
输出下降时间	t_f	$CL=50\text{pF}$	—	—	0.2	μs

XL534 磁性能参数 (注 2)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = V_{Pull} = 5\text{V}$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, $R_1 = 0\Omega$, 图1系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
带宽	f_{BW}	—	—	—	100	kHz
磁场工作点	B_{OP}	—	+20	+55	+90	Gs
磁场释放点	B_{RP}	—	-90	-55	-20	Gs
磁滞	B_{HYS}	—	—	110	—	Gs
磁场对称性	B_O	$B_O = (B_{OP} + B_{RP})/2$	-35	0	+35	Gs

注 2: $1\text{mT}=10\text{Gs}$; 磁场南极 (S) 正对芯片丝印面定义为正磁场; 在磁滞范围内通电, 允许不确定的输出状态, 在第一次超出 B_{OP} 或 B_{RP} 之后, 就可以达到正确的状态。

锁存型霍尔开关传感器

XL534

特性曲线（注3）

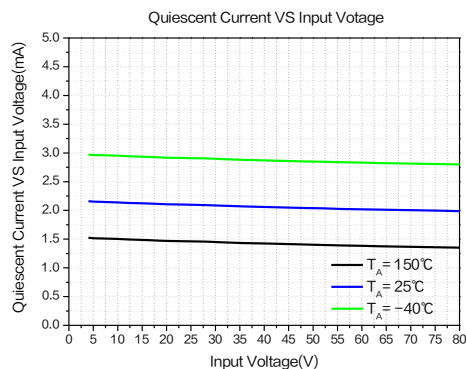


图 5.静态电流曲线图

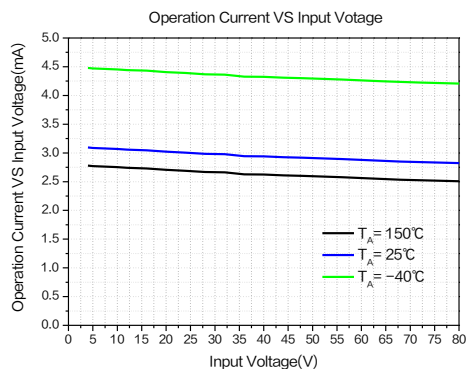


图 6.工作电流曲线图

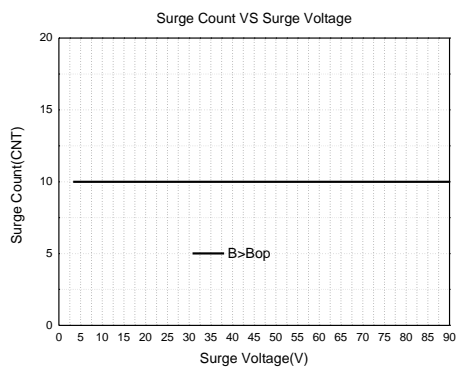


图 7.输出端抗浪涌电压曲线图

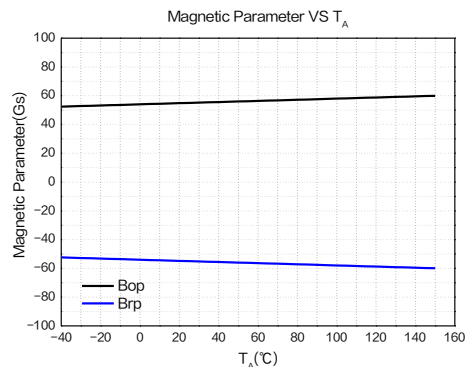


图 8.磁工作点随温度变化曲线图

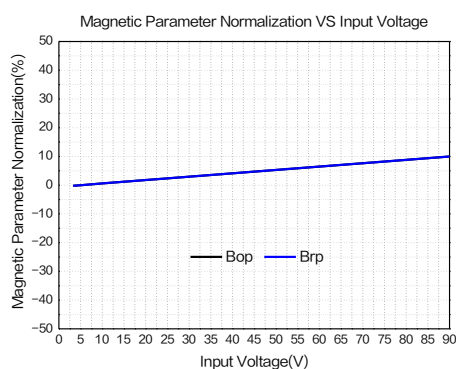


图 9.磁工作点随输入电压变化曲线图

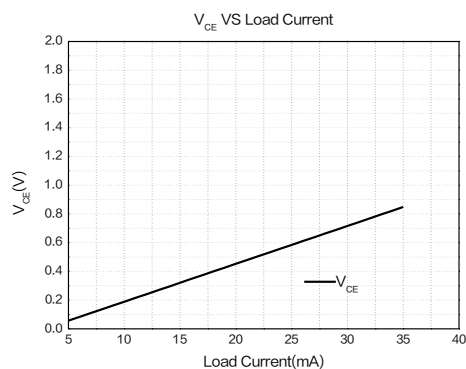


图 10.饱和压降随负载电流变化曲线图

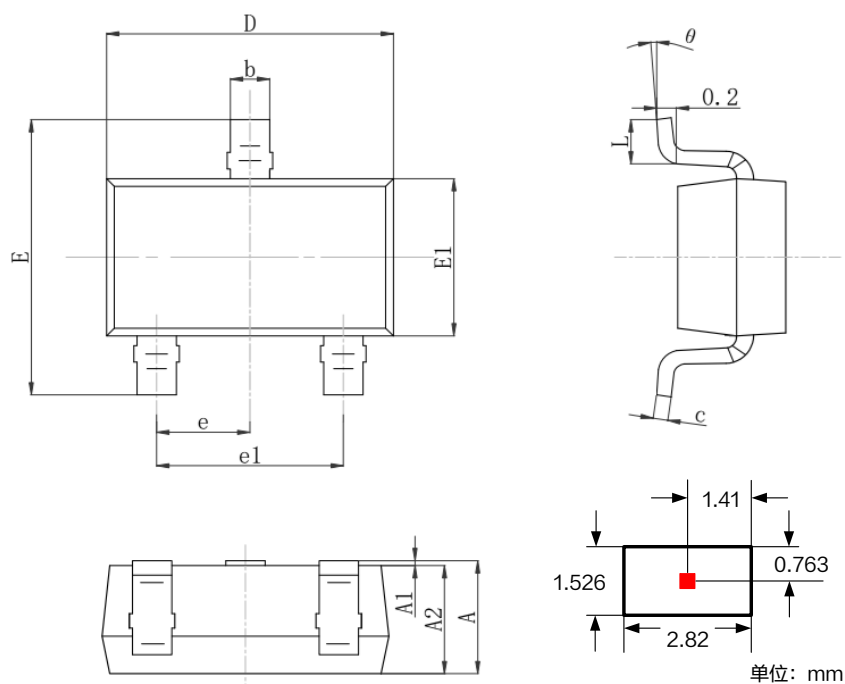
注 3: 图 7 的浪涌电压为高电平宽度 $5\mu s$, 周期 $20\mu s$ 的方波, 该方波为 10 个周期。

锁存型霍尔开关传感器

XL534

物理尺寸

SOT23-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.000	1.350	0.039	0.053
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	1.000	1.200	0.039	0.047
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.050	0.111	0.120
E1	1.500	1.726	0.059	0.068
E	2.600	3.000	0.102	0.118
e	0.950 REF		0.037 REF	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 www.xlsemi.com。